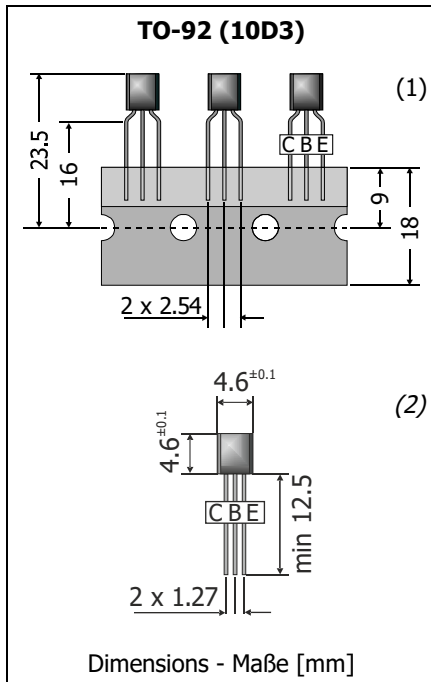


BC327 ... BC328 General Purpose PNP Transistors Universal-PNP-Transistoren	$I_C = -800 \text{ mA}$ $h_{FE} \sim 160/250/400$ $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$	$V_{CE0} = -25 \dots -45 \text{ V}$ $P_{tot} = 625 \text{ mW}$
---	--	---

Version 2018-02-02



Typical Applications

Signal processing,
Switching, Amplification
Commercial grade ¹⁾

Features

General Purpose
Three current gain groups
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

- (1) Taped in ammo pack (Raster 2.54) 4000
- (2) On request: in bulk (Raster 1.27, suffix "BK") 5000

Weight approx. 0.18 g
Case material UL 94V-0
Solder & assembly conditions 260°C/10s
MSL N/A

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
Schalten, Verstärken
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Universell anwendbar
Drei Stromverstärkungsklassen
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

- (1) Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)
- (2) Auf Anfrage: Schüttgut (Raster 1.27, Suffix "BK")

Gewicht ca. 0.18 g
Gehäusematerial UL 94V-0
Löt- und Einbaubedingungen 260°C/10s



Current gain groups Stromverstärkungsgruppen		Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren
BC327-16 BC327-25 BC327-40	BC328-16 BC328-25 BC328-40	BC337 ... BC338

Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

			BC327	BC328
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	E-B short	- V_{CES}	50 V	30 V
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V_{CEO}	45 V	25 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- V_{EBO}	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	625 mW ³⁾	
Collector current – Kollektorstrom	DC	- I_C	800 mA	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- I_{CM}	1 A	
Base current – Basisstrom		- I_B	100 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-55...+150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-55...+150°C	

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
2 $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben
3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

				$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾							
- $V_{CE} = 1\text{ V}$	- $I_C = 100\text{ mA}$	Group -16	h_{FE}	100	160	250	
		Group -25		160	250	400	
		Group -40		250	400	630	
	- $I_C = 300\text{ mA}$	Group -16	h_{FE}	60	130	–	
		Group -25		100	200	–	
		Group -40		170	320	–	
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. ¹⁾							
- $I_C = 500\text{ mA}$	- $I_B = 50\text{ mA}$		- V_{CEsat}	–	–	0.7 V	
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾							
- $V_{CE} = 1\text{ V}$	- $I_C = 300\text{ mA}$		- V_{BE}	–	–	1.2 V	
Collector-Emitter cutoff current – Kollektor-Emitter-Reststrom							
- $V_{CE} = 45\text{ V}$	B-E short	BC327 BC328	- I_{CES}	–	2 nA	100 nA	
- $V_{CE} = 25\text{ V}$							
- $V_{CE} = 45\text{ V}$	B-E short	BC327 BC328	- I_{CES}	–	–	10 μA	
- $V_{CE} = 25\text{ V}$							$T_j = 125^\circ\text{C}$
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz							
- $V_{CE} = 5\text{ V}$,	- $I_C = 10\text{ mA}$,	- $f = 50\text{ MHz}$	f_T	–	100 MHz	–	
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität							
- $V_{CB} = 10\text{ V}$,	$I_E = I_E = 0$,	$f = 1\text{ MHz}$	C_{CBO}	–	12 pF	–	
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung			R_{thA}	< 200 K/W ²⁾			

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)

Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

¹ Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

² Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden